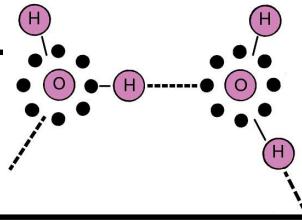


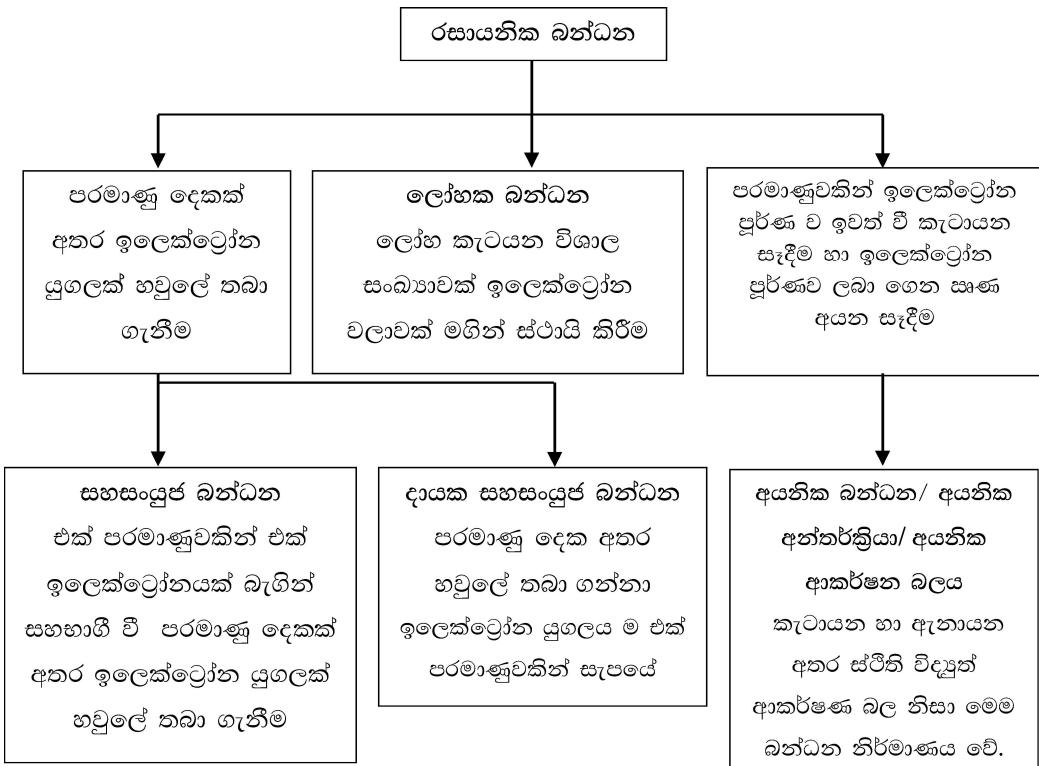
ව්‍යුහය හා බන්ධන



නැඳින්වීම

රසායනික බන්ධන සහ අණුවල ව්‍යුහ යනු ප්‍රතිච්‍රිත හා රසායනික ගුණ විස්තර කිරීම සඳහා තුළත පරමාණුක ආකෘතිය පදනම් කර ගනීම් මිනිසා විසින් ගෙවීනෙන ලද ආකෘතියකි.

සංයුරතා කවචයේ ස්ථායි ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්කාසයක් නොමැති මූලුවෙන පරමාණු විම අඩුව සපුරා ගැනීමට දරන උත්සාහයේ ප්‍රතිච්‍රිත ලෙස රසායනික බන්ධන නිර්මාණය වේ යැයි සලකනු ලබයි. රසායනික බන්ධන සඳහා සංයුරතා කවච ඉලෙක්ට්‍රෝන සහනාගි වන ආකාරය පිළිබඳ දැනට පිළිගත් ආකෘතින් හි මුහුණු සටහන් පහත පරිදි දැක්වීය හැකි ය.



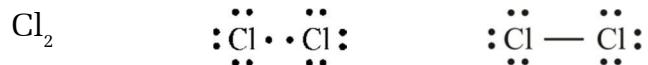
සහසංයුරු බන්ධන

වික ම විරිගයේ මූලුවෙන පරමාණු දෙකක් අතර හෝ විකිනෙකට වෙනස් මූලුවෙන පරමාණු දෙකක් අතර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලක් හවුලේ තබා ගැනීම මිනා සහසංයුරු බන්ධන නිර්මාණය වේ. හවුලේ අටින ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල සමන්විත වී ඇත්තේ විම වික් පරමාණුවකින් වික් ඉලෙක්ට්‍රෝනය බැඟින් සපයීම නිසාය. සංයුරතා කවචයේ මූල ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව සැලකු විට, ඉහත ක්‍රියාවලිය නිසා බොහෝ විට පරමාණු දෙක අනෙක්නා වශයෙන් ස්ථායි ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්කාස අත් කර ගනී.

ලුවිස් තිත් සටහන හා ලුවිස් තිත් - ඉරු ව්‍යුහ

ලුවිස් තිත් සටහන යොදා ගෙනු ලබන්නේ යම් රසායනික සූත්‍රයකට අනුරූප වූ පරමාණුක සඡකීල්ල, බන්ධන ස්වභාවය (තනි, ද්වීතීය හා තීත්ව බන්ධන) හා විම පරමාණුවල සංයුජතා කළව ඉලෙක්ට්‍රෝන වන්ඩ්තිය විද්‍යා දැක්වීමට ය. ලුවිස් තිත්-ඉරු ව්‍යුහ වල බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුත්මයක් වෙනුවට පරමාණු අතර කළ කෙරී ඉරක් සලකුණු කරනු ලැබේ.

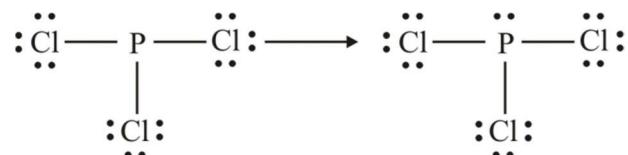
රසායනික සූත්‍රය → ලුවිස් තිත් සටහන → ලුවිස් තිත්-ඉරු ව්‍යුහය



ලුවිස් තිත් සටහන ඇඳුමේදී පරමාණු දෙකක් අතර බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන පහත සඳහන් ආකාරවලට නිර්ජ්‍යතාය කළ හැකි ය.

වීක බන්ධනය	→ M : L	හෝ	M .. L
ද්වීතීය බන්ධනය	→	M :: L	
තීත්ව බන්ධනය	→	M :: L	
දායක බන්ධනය L සිට M දක්වා →	L : M		

පර්යන්ත පරමාණු වටා විකසර යුගල් සටහන් කිරීම (අභ්‍යෑකය පූර්ණ වන පරිදි) පූර්ණ කළ පසු තවත් ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ඉතිරි වේ නම්, විනි මධ්‍ය පරමාණුව මත විම ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල සලකුණු කරනු ලැබේ.



PCl_3 හි ලුවිස් තිත්-ඉරු ව්‍යුහය

NH_2^- අයනය සලකම්



මෙති N පරමාණුව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන අවකි. නයිට්‍රෝන් පරමාණුව ඉලෙක්ට්‍රෝන පහක් සපයා අනත් ඉහත ලුවිස් තිත් සටහන අනුව N මගින් සපයන ලද ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන භයාකි. වික් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් වැඩිපූර අති නිසා N හි විධිමත් ආයෝජනය -1 කි. විම ආරෝපණය N පරමාණුව අසම්පූර්ණ සටහන් කර ඇත.

නොරා ගත අණු සහ අයන කිහිපයක ලුවිස් තිත් සටහන් හා ලුවිස් තිත්-ඉරි ව්‍යුහ

සුදුසා සංස්කරණ ක්‍රම ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන	ප්‍රවිස් තිත් සටහන	ලුවිස් තිත්-ඉරි ව්‍යුහ
CO_2	16	$\ddot{\text{:O}} \text{:} \text{:} \text{C} \text{:} \text{:} \ddot{\text{O}}:$ $\ddot{\text{:O}} = \text{C} = \ddot{\text{O}}$
POCl_3	32	$\begin{array}{c} \text{:O:} \\ \text{:Cl:} \text{:} \text{P} \text{:} \text{Cl:} \\ \text{:Cl:} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{:Cl:} \\ \text{:Cl:} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{:O:} \\ \text{:Cl} \text{:} \text{P} \text{:} \text{Cl:} \\ \text{:Cl:} \end{array}$
HCN	10	$\text{H} \text{:} \text{C} \text{:} \text{:} \text{N} \text{:}$ $\text{H} — \text{C} \equiv \text{N}:$
NO_2^-	18	$\begin{array}{c} \text{:O:} \\ \text{:O:} \end{array} \text{:} \text{N} \text{:} \text{:} \text{O:}$ $\begin{array}{c} \text{:O:} \\ \text{:O:} \end{array} \text{—} \text{N} \text{=} \text{O:}$
NO_3^-	24	$\begin{array}{c} \text{:O:} \\ \text{:O:} \end{array} \text{:} \text{N} \text{:} \text{:} \text{O:}$ $\begin{array}{c} \text{:O:} \\ \text{:O:} \end{array} \text{—} \text{N}^+ \text{=} \text{O:}$
NO_2^+	16	$\begin{array}{c} \text{:O:} \\ \text{:O:} \end{array} \text{:} \text{N} \text{:} \text{:} \text{O:}$ $\begin{array}{c} \text{:O:} \\ \text{:O:} \end{array} \text{—} \text{N}^+ \text{=} \text{O:}$

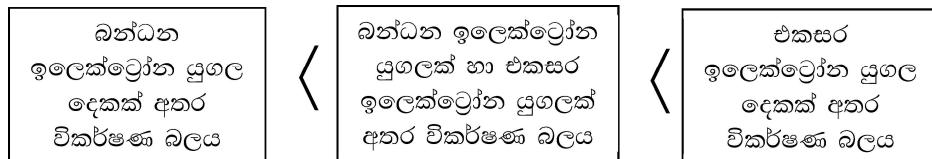
නොරා ගත් අණු සහ අයන කිහිපයක ලුවිස් තිත්-ඉරි ව්‍යුහ, මධ්‍ය පරමාණුව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් සහ විකර්ණ ඒකක

ලුවිස් තිත්-ඉරි ව්‍යුහය	මධ්‍ය පරමාණුව වටා ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ගණන	මධ්‍ය පරමාණුව වටා ඇති විකර්ණ ඒකක ගණන (VSEPR ඒකක ගණන)
$\ddot{\text{:O}} = \text{S} = \ddot{\text{O}}$	5	3
$\begin{array}{c} \text{:Cl} \\ \diagdown \\ \text{:Cl} \text{:} \text{S} \text{—} \text{O:} \\ \diagup \end{array}$	5	4
$\begin{array}{c} \text{:O:} \\ \parallel \\ \text{:O:} \end{array}$	6	3
$\text{H} — \text{C} \equiv \text{N}:$	4	2
$\begin{array}{c} \text{:O:} \\ \text{:O:} \end{array} \text{—} \text{N}^+ \text{=} \text{O:}$	4	2

VSEPR වාදය

මෙම VSEPR වාදය අනුව අණු සහ අයන ඒවා අතර විකර්ෂණ බලය අවම වන පරිදි විකර්ෂණ ඒකක විසිනේ ඇත් එම ඒවා අතර පර්තරය වැඩිකරගෙන ස්ථාපි වී ඇත.

විකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලේ අවකාශ ව්‍යුහ්පතිය (අවකාශ පර්මාවක්) බහ්දින ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලක අවකාශ ව්‍යුහ්පතියට වඩා වැඩි ය. ව්‍යුහ්පති විකසර යුගල් දෙකක (විකසර යුගල \leftrightarrow විකසර යුගල) අතර ක්‍රියාත්මක වන විකර්ෂණ බලවල ප්‍රබලතාව, බහ්දින ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් දෙකක් (බහ්දින යුගල \leftrightarrow බහ්දින යුගල) අතර ක්‍රියාත්මක වන විකර්ෂණ බලවල ප්‍රබලතාවට වඩා වැඩි යැයි සළකනු ලබයි. මේ නිසා විකසර යුගලක් හා බහ්දින ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලක් (බහ්දින යුගල \leftrightarrow විකසර යුගල) අතර ක්‍රියාත්මක වන විකර්ෂණ බලවල ප්‍රබලතාවට වඩා වැඩි යැයි සළකනු ලබයි.



බහ්දින යුගල හා එකසර යුගල අතර විකර්ෂණ බල සංස්දහය

විකර්ෂණ ඒකක (බහ්දින ඉලෙක්ට්‍රෝන හෝ විකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන) විම ඒකක කේන්ඩ්‍ය පර්මාණුව මූලික කර ගනිමින් අවකාශයේ ව්‍යුහ්පති වී ඇති රටාව 'ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය' වශයෙන් හඳුන්වේ. අනුවක හෝ අයනයක ජ්‍යාමිතියක් දැක්වන විට බහ්දින කේතායේ අයය දැක්විය යුතු ය. පහත වගුවේ දැක්වා ඇත්තේ කේන්ඩ්‍ය පර්මාණුව වටා ඇති විකර්ෂණ ඒකක තුමානු අවකාශයේ ව්‍යුහ්පත්ව පවතින ආකාරය අනුව ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය් වෙනස්වන අන්ත්‍රම ය. අනුවක හෝ අයනයක හඳුය දැක්වීමේ දී කේතාය දැක්වීම අනිවාර්ය නො වේ. වෙහෙත් අනුවක හෝ අයනයක ජ්‍යාමිතිය දැක්වීමේ දී කේතාය දැක්වීම අනිවාර්ය වේ. මේ නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය, අනුවක හෝ අයනයක හෝ හඳුය හා අනුවක හෝ අයනයක ජ්‍යාමිතිය යනු වෙනස් අවස්ථා තුනකි.

අනුවල ජ්‍යාමිතිය මගින් විනි හඳුය හා කේතා ගෙන දෙනු ලබයි. අනුවල ජ්‍යාමිතිය, හඳුය නිර්පත්තය වන ලුවිස් ව්‍යුහයේ බහ්දින කේතා හා සම්බන්ධ වී ඇත. බහ්දින කේතා නොමැතිව හඳුය නිර්පත්තය කිරීමට අනුවෙනි හඳුය ලුවිස් ව්‍යුහය මගින් පෙන්නුම් කරයි. ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය විකර්ෂණ ඒකකවල ජ්‍යාමිතිය පෙන්නුම් කරයි.

විකර්ෂණ ඒකකවල ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යෙමිනිය

විකර්ෂණ ඒකක	ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යෙමිනිය
2	
3	
4	
5	
6	

(i) ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යෙමිනිය රේඩීය වූ අවස්ථාව

මෙහි දී කේන්ද්‍රීය පරමාණුව වටා VSEPR ඒකක දෙකක් ඇත. කේන්ද්‍රීය පරමාණුව වත්ත් පරමාණු දෙකක් හා බැඳී ඇති අවස්ථා සඳහා. විවැනි අත්තු හා අයනවල හැඩිය රේඩීය වේ. රේඩීය හැඩිය සඳහා නිදසුන් කිහිපයක් පහත වගුවේ දක්වා ඇත.

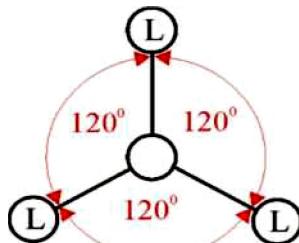
විකර්ෂණ ඒකක දෙකක් සහිත අතු/අයන

සූත්‍රය	ලුටිස් තිත්-ශුරි ව්‍යුහය	හැඩිය
CO_2	$\ddot{\text{O}} = \text{C} = \ddot{\text{O}}$	රේඩීය
HCN	$\text{H} - \text{C} \equiv \text{N}:$	රේඩීය
NO_2^+	$\ddot{\text{O}} = \overset{+}{\text{N}} = \ddot{\text{O}}$	රේඩීය

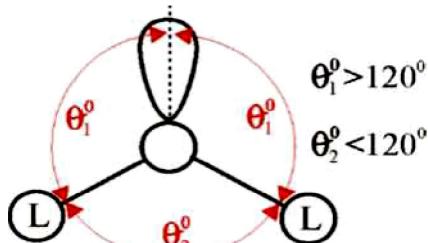
(ii) ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල පසාමිතිය තළීය ත්‍රිකෝණාකාර අවස්ථාව

විකසර හා බහුඛල ලෙස ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල වෙන් කළ විට ඇ, ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් පසාමිතින් ආකාර දෙකක් හඳුනා ගත හැක.

- විකර්ෂණ ඒකක (VSEPR ඒකක) තුන ම බහුඛල වන අවස්ථාව
- විකර්ෂණ ඒකක (VSEPR ඒකක) තුනෙන් දෙකක් බහුඛල ද ඉතිරි VSEPR ඒකකය විකසර යුගලක් ද වන අවස්ථාව



(a)



(b)

විකර්ෂණ ඒකක තුන ම බහුඛල ලෙස වූ අවස්ථාව

විකර්ෂණ ඒකක තුනෙන් දෙකක් බහුඛල හා එකක් එකසර වන අවස්ථාව

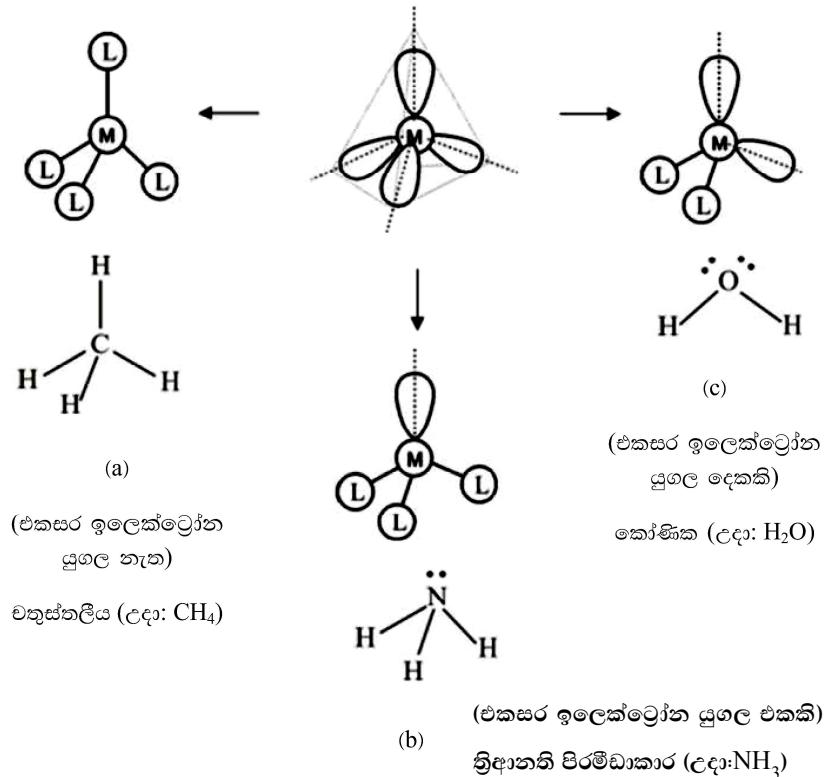
පහත දැක්වෙන BF_3 , SO_3 හා H_2CO අණුවල මධ්‍ය පර්මාණුව ආණුත්ව විකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන නැත. විම නිසා හැඩිය තළීය ත්‍රිකෝණාකාර වේ අයෙන්. විනෙන් SO_2 හා S මත විකසර යුගලක් තිබෙන නිසා හැඩිය කොළඹික ය.

විකර්ෂණ ඒකක තුනක් සහිත අණු/අයෙන

රසායනික සූච්‍ය	හැඩි නිරුපණය වන පරිදි උච්චි තින්-ඉරු වුළුහය	හැඩිය
BF_3	 B :F: :F: :F:	තළීය ත්‍රිකෝණාකාර
SO_3	 S :O: :O: :O:	තළීය ත්‍රිකෝණාකාර
H_2CO		තළීය ත්‍රිකෝණාකාර
SO_2		කොළඹික

(iii) ඉලෙක්ට්‍රෝන් යුගල ජාමිතිය වනුස්ථාපීය අවස්ථාව

විකර්ෂණ ඒකක (VSEPR යුගල) හතරක් ඇති අවස්ථාව සඳහා විට, ඒවා බන්ධන යුගල හා විකසර යුගල ලෙස වෙන් කිරීමෙන් ආකාර තුනක් ලබා ගත හැක. පහත විම අවස්ථා තුන විද්‍යා දැක්වේ.



වනුස්ථාපීය ඉලෙක්ට්‍රෝන් යුගල ජාමිතිය

වනුස්ථාපීය හැඩිය සඳහා තවත් නිදුසුන් කිහිපයක් පෙන්නුම් කරයි.

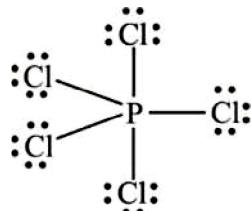
වනුස්ථාපීය අනු සහ අයන සඳහා නිදුසුන්

අනුව	ලුවිස් ව්‍යුහය	හැඩිය දැක්වෙන ලුවිස් ව්‍යුහය
CH ₄	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$
CCl ₄	$\begin{array}{c} :\ddot{\text{Cl}}: \\ \\ :\ddot{\text{Cl}}-\text{C}-\ddot{\text{Cl}}: \\ \\ :\ddot{\text{Cl}}: \end{array}$	$\begin{array}{c} :\ddot{\text{Cl}}: \\ \\ :\ddot{\text{Cl}}-\text{C}-\ddot{\text{Cl}}: \\ \\ :\ddot{\text{Cl}}: \end{array}$
SO ₄ ²⁻	$\begin{array}{c} :\ddot{\text{O}}: \\ \\ -\ddot{\text{O}}-\text{S}-\ddot{\text{O}}- \\ \\ :\ddot{\text{O}}: \end{array}$	$\begin{array}{c} :\ddot{\text{O}}: \\ \\ -\ddot{\text{O}}-\text{S}-\ddot{\text{O}}- \\ \\ :\ddot{\text{O}}: \end{array}$

(iv) ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජක්මිතිය ව්‍යාහන දීවිජිරූපිකාර අවස්ථාව

මධ්‍ය පරමාණුව වටා ඇති විකර්ෂණ ඒකක හෙවත් VSEPR ඒකක පහති. බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන හා විකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන ලෙසට වෙන් කිරීමෙන් හැඩියන් ආකාර හතරකි.

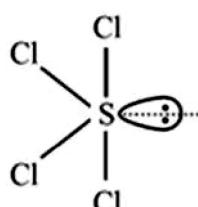
- මධ්‍ය පරමාණුව වටා වූ VSEPR ඒකක පහ ම බන්ධන සාදන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ලෙස පැවතීම, PCl_5 අණුව මේ නිදුසුනක් වන අතර, විෂි හැඩිය පහත දැක්වා ඇත.



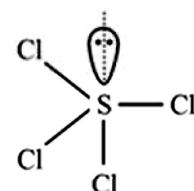
PCl_5 හි ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජක්මිතිය

- මධ්‍ය පරමාණුව වටා වූ VSEPR ඒකක විකක් පමණක් විකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලක් හා ඉතිරි විකක හතර ම බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල වීම. SCl_4 අණුව මේ නිදුසුනකි.

පහත දැක්වෙන පරිදි මෙති සාල්‍යාර් පරමාණුවේ ඇති විකසර යුගලට තිබිය හැකි පිහිටීම දෙකකි.



(a)

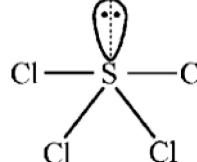


(b)

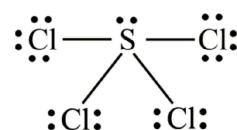
(b) ව්‍යුහයේ දීට වඩා (a) ව්‍යුහයේදී විකර්ශනය අඩුය. විඛැවීන් VSEPR ආකෘතියට අනුව, (a) ව්‍යුහය (b) ව්‍යුහයට වඩා ස්ථායි වේ.

- විකසර යුගලක් හා බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල හතරක් ඇති අවස්ථාවට සෙක්ද්ධාන්තික ලෙස සිසේෂ හැඩියක් (විකෘත සිසේෂ හැඩියක්/ අනුමතවත් සිසේෂ හැඩියක්) ඇතැයි කියනු ලැබේ. විකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලටි ව්‍යුහාත්මක දැක්වෙන මන්කළුපිත අක්ෂය සහ $\text{S}-\text{Cl}$ බන්ධන දෙකක් විෂි තලයක ඇත. විම තලයට ලැබුක වන පරිදි ඉතිරි $\text{S}-\text{Cl}$ බන්ධන දෙක පිහිටා ඇත.

විකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල සඳහා මන්කළුපිත අක්ෂය

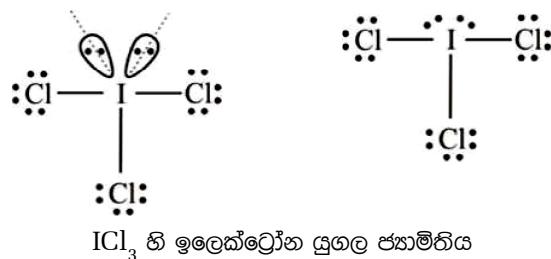


SCl_4 හි ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජක්මිතිය



කෙසේ වෙන් විකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයේ $\text{S}-\text{Cl}$ බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන මත ඇතිවන විකර්ෂණ බල තිසු නියමාකාර සිසේෂ හැඩිය ස්වල්ප වශයෙන් විකෘත වේ. විම තිසු SCl_4 හි හැඩිය විකෘත වූ වතුස්තලය / විකෘත සිසේෂ හැඩිය / අනුමතවත් සිසේෂ හැඩිය වශයෙන් ද හඳුන්වනු ලැබේ.

- විකර්ෂණ ඒකක තුනක් බන්ධන යුගල ලෙස ද අනෙක් දෙක විකසර යුගල ලෙස ද පැවතීම. නිදසුනක් ලෙස ICl_3 විකසර යුගල දෙකක් හා බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල තුනක් ඇති ICl_3 හි විකර්ෂණ බල අවම වන වඩාත් ම ස්ථායී අවස්ථාව පහත රෘප සටහනේ දැක්වේ. විම සැකස්ම ම තුමනුය කළ විට දී පර්යන්ත පරමාණු T ඇක්ෂරයේ හැඩියට පිහිටින අවස්ථාවක් පවතී. විනෙකින් විය T හැඩිය අණුවක් ලෙස (විකාති T හැඩිය/අණුමවත් T හැඩිය) හැඳුන්වේ. මෙහි විකසර යුගල දෙක හා වික් I - Cl බන්ධනයක් වික ම තෙයේ පිහිටිය. විම තෙයට ලම්බක වන පරිදි ඉතිරි I - Cl බන්ධන දෙක පිහිටිය.

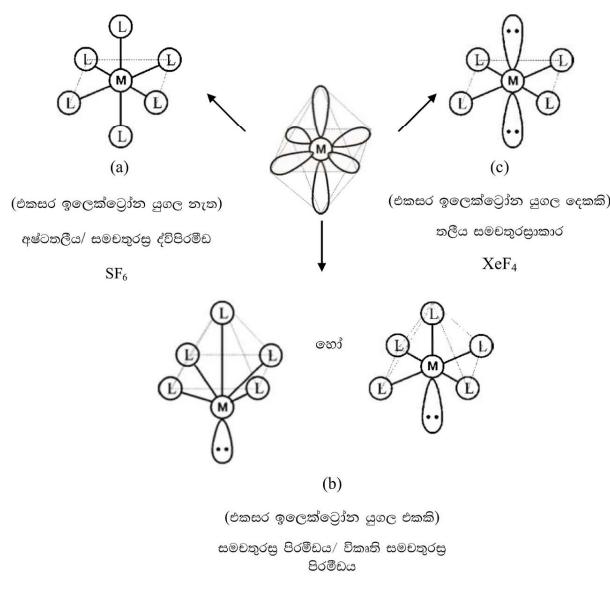


- විකසර යුගල තුනක් හා බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල දෙකක් අඩංගු අවස්ථාව සඳහා නිදසුනක් ලෙස XeF_2 සලකා බවමු. මෙවැනි සංකලනයක දී සියලු පරමාණු විකම රේඛාවක පිහිටින හෙයින් රේඛීය හැඩියක් ඇතැයි කියනු ලැබේ. XeF_2 හි හැඩිය දැක්වෙන පරිදි අදින එද ලුවිස් ව්‍යුහය පහත දැක්වා ඇත. විනි විකසර යුගල් තුන ම වික ම තෙයක පිහිටින අතර විය F - Xe - -F ඇක්ෂයට ලම්බක වේ.



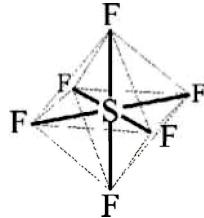
(v) ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය අශ්විතලීය අවස්ථාව

මෙම ජ්‍යාමිතියේ දී සැම යාඛද විකර්ෂණ ඒකක දෙකක් අතර කේතුය 90° කි. පහත රෘපයෙන් අශ්විතලීය ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය ඇති අණුවක් සඳහා තිබිය හැඩි හැඩි තුනක් පෙන්වුම් කෙරේ. ඒකක හතරක් වික ම තෙයක ඇත. ඉතිරි විකක දෙක විම තෙයට ලම්බකව ඇත.



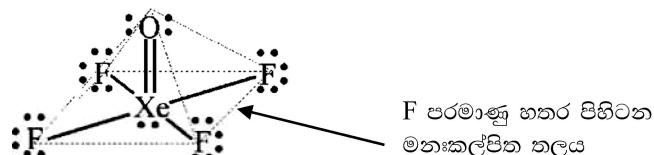
අශ්විතලීය ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය

විකර්ෂන ඒකක සීයල්ල බන්ධන බවට පත් වූ අවස්ථාවක් (ලභ: SF_6) සලකමු. වඩාත් පර්යන්තව ඇති යාබදු පරමාණු මහාකළේපිත රේඛාවකින් (කඩ ඉර) යා කළ විට තම අවකින් වට වූ අෂ්ට්‍රතලයක් නිර්මාණය වේ. විම නිසා මෙවත් අනු වල නැඩය අෂ්ට්‍රතලීය වේ.



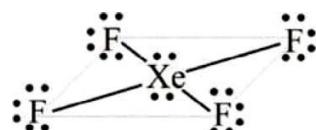
SF_6 හි ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යෙගල ජ්‍යෙමිනිය

විකර්ෂන ඒකක හයෙන් පහක් ම බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන නියෝජනය කරන හා ඉතිරි විකර්ෂන ඒකකය විකසර යුගලක් වන අවස්ථාව සලකමු ($XeOF_4$). $XeOF_4$ හි ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යෙමිනිය අෂ්ට්‍රතලීය වේ. වඩාත් පර්යන්ත පරමාණු මහාකළේපිත රේඛාවකින් යා කළ විට, පාද්‍යෝගී සමවතුරසුයක් වූ පිරිමීඩයක් නිර්මාණය වේ. විනිසා නැඩය සමවතුරසු පිරිමීඩාකාර ය. පහත රුපයෙන් පෙන්නුම් කෙරෙන $XeOF_4$ මේට නිදුසුනකි. නමුත් Xe පරමාණුව මත වූ විකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයෙන් $Xe - F$ බන්ධන මත වූ විකර්ෂන බල නිසා කුමවත් නැඩය වෙනස් වී අතුමවත් වතුරසු පිරිමීඩාකාර නැඩයක් ඇති වී ඇතැයි සලකනු ලැබේ.



$XeOF_4$ හි ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යෙගල ජ්‍යෙමිනිය

විකර්ෂන ඒකක හයෙන් දෙකක් විකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ද, ඉතිරි ඒකක හතර බන්ධන යුගල ද වන අවස්ථාව සලකමු. විනි නැඩය තලීය සමවතුරසුකාර යැයි කියනු ලැබේ. XeF_4 අනුව මේට නිදුසුනකි. විය පහත රුපයෙන් පෙන්නුම් කෙරේ.

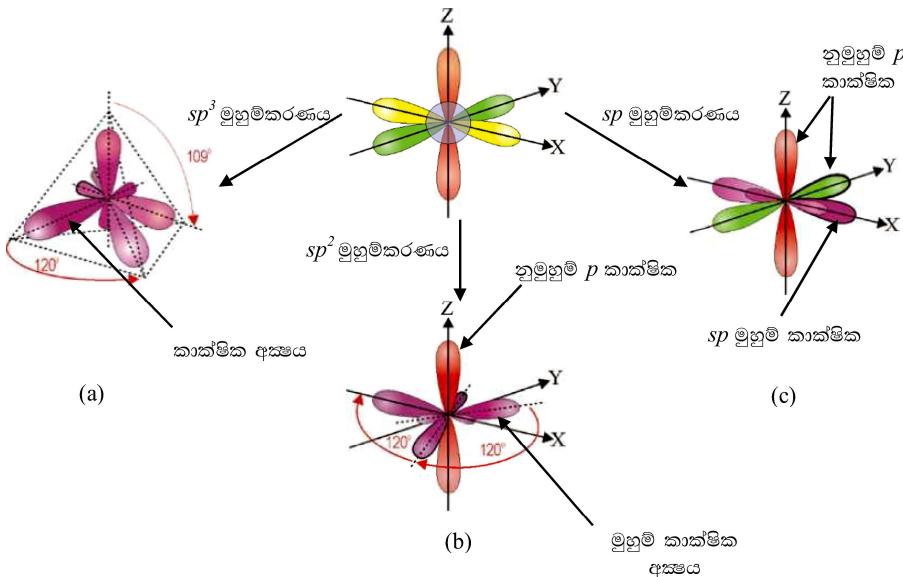


XeF_4 හි ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යෙගල ජ්‍යෙමිනිය

මුහුමිකරණය

මුහුමිකරණය නැමැති ක්‍රියාවලිය සන්ස වශයෙන් ම සිදු වන හෝතික ක්‍රියාවලියක් නොව සංක්ලේපයක් ලෙස ඉදිරිපත් කරන අපුරුව මන්කල්පිත ක්‍රියාවලියකි. මේ මන්කල්පිත සංක්ලේපය ක්‍රියාවට අනුව උත්තේපිත අවස්ථාවේ වූ කාබන් පරමාණුව ආශ්‍රිතව විකිණීකරණ වෙනස් මුහුමිකරණ අවස්ථා තුනක් පවතියි. කාබන් පරමාණුව ආශ්‍රිත මුහුමිකරණය පහත සාරාංශ කර දෙක්වා ඇත.

- (i) s කාක්ෂිකය සමඟ p කාක්ෂික තුනම මිශ්‍ර විමෙන් sp^3 මුහුමිකාක්ෂික හතරක් සඳහා (වතුස්ථාපිත ජ්‍යාමිතිය)
- (ii) s කාක්ෂිකය සමඟ p කාක්ෂික දෙකක් මිශ්‍ර විමෙන් sp^2 මුහුමිකාක්ෂික තුනක් සඳහා (තලීය ත්‍රිකෝණාකාර ජ්‍යාමිතිය)
- (iii) s කාක්ෂිකය සමඟ p කාක්ෂික විකක් මිශ්‍ර විමෙන් sp මුහුමිකාක්ෂික දෙකක් සඳහා (රේඛිය ජ්‍යාමිතිය)



sp^3 , sp^2 හා sp මුහුමි කාක්ෂිකවල හැඩය හා s හා p කාක්ෂික ගුණ ප්‍රතිශ්‍යාය සංස්ඨ්ධනය කෙරේ.

	sp^3 මුහුමි කාක්ෂික	sp^2 මුහුමි කාක්ෂික	sp මුහුමි කාක්ෂික
s කාක්ෂික ගුණ	25%	33.3%	50%
p කාක්ෂික ගුණ	75%	66.3%	50%

(a) sp^3 මුහුමි කාක්ෂිකවල දිගානතිය

මුහුමි කාක්ෂික වතුස්ථාපිතයක් තුළ පිහිටා ඇත. කාක්ෂිකවල අක්ෂ අතර කෝණය $109^{\circ} 28'$ වේ.

(b) sp^3 මුහුමි කාක්ෂිකවල දිගානතිය

මුහුමි කාක්ෂිකවල අක්ෂ තුන වික ම තලයක පිහිටා ඇත. මුහුමි කාක්ෂිකවල අක්ෂ අතර කෝණය 120° කි. මුහුමිකරණයට සහභාගි නොවූ p කාක්ෂිකය මෙම තලයට ලමිඩක වේ.

(c) sp මුහුමි කාක්ෂිකවල දිගානතිය

මුහුමි කාක්ෂිකවල අක්ෂ දෙක ම වික ම සරල රේඛාවක පවතී. මුහුමි කාක්ෂික අක්ෂ අතර කෝණය 180° කි.

මුහුමිකරණයට සහභාගි නොවූ p කාක්ෂික අක්ෂ විකිණීකරණය නොවූ p කාක්ෂික අක්ෂයට ලමිඩක වේ.